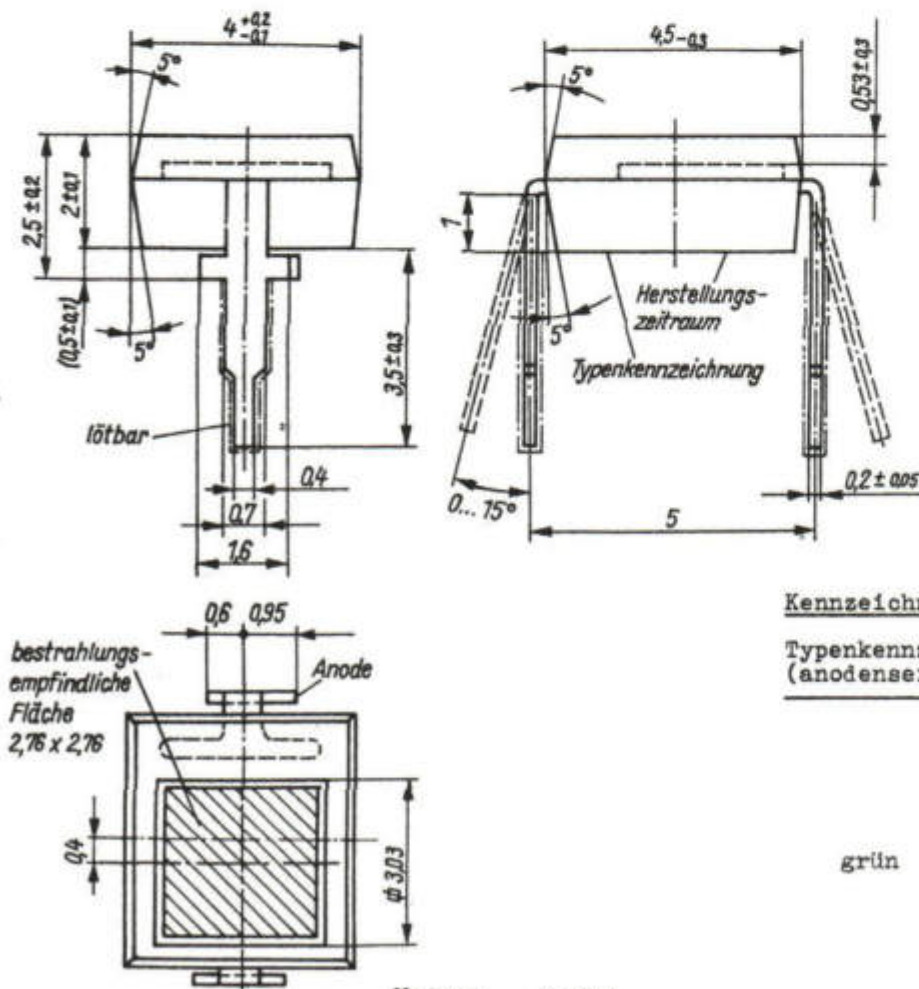


Fotodiode SP106

RFT

Planare Si-pin-Fotodiode in einem transparenten Kunststoffgehäuse. Sie ist durch hohe Fotoempfindlichkeit im hohen Infrarotbereich, durch ein geringes Dunkelstromniveau und durch kurze Schaltzeiten gekennzeichnet.

Die Fotodiode SP 106 ist zur allgemeinen Anwendung als Empfänger für die Infrarotsignalübertragung geeignet.



Kennzeichnung

Typenkennzeichnung
(anodenseitig)

Herstellungsjahr
(katodenseitig)

grün

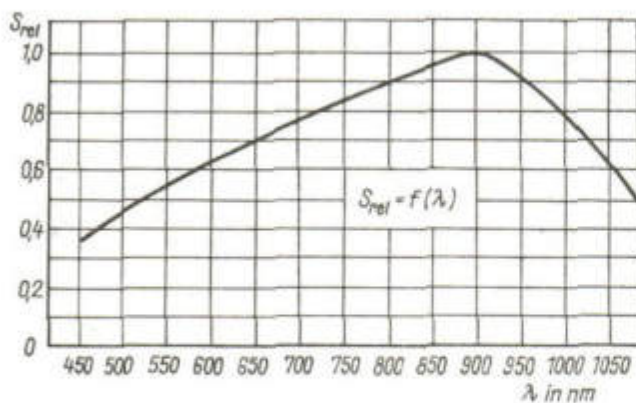
Masse: 0,2 g
Standard: TGL 42943

1986	grün
1987	gelb
1988	rot
1989	grau
1990	braun
1991	rose
1992	weiß
1993	orange
1994	schwarz
1995	blau

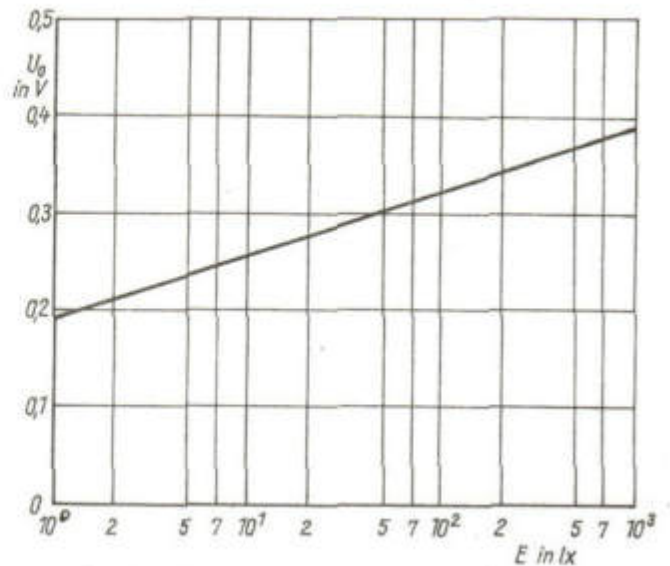
Kenngrößen bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$		min.	typ.	max.	
Leerlaufspannung ¹⁾	U_0	330	400	-	mV
$E_v = 1 \text{ klx}$					
$R_L = 10^7 \text{ Ohm}$					
Kurzschlußstrom ¹⁾	I_K	50	75	-	μA
$E_v = 1 \text{ klx}$					
$R_L = 10 \text{ Ohm}$					
Dunkelstrom	I_{RO}	-	1	30	nA
$E_e = 0$					
$U_R = 10 \text{ V}$					
Gesamtkapazität	C_{tot}	-	20	35	pF
$E_e = 0$					
$U_R = 10 \text{ V}$					
$f = 1 \text{ MHz}$					
Spektrale Empfindlichkeit	S_λ	0,5	0,6	-	A/W
$U_R = 10 \text{ V}$					
$\lambda = 850 \text{ nm}$					
Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit	λ_D	-	900	-	nm
Impulsanstiegszeit	t_R	-	15	80	ns
Impulsabfallzeit	t_f	-	20	80	ns
$U_R = 10 \text{ V}$					
$\lambda = 900 \text{ nm}$					
$R_L = 50 \text{ Ohm}$					

Grenzwerte bei $\vartheta_a = -25 \dots +85^\circ\text{C}$				
Sperrgleichspannung	U_R	-	-	25 V
Periodische Spitzensperrspannung	U_{RRM}	-	-	25 V
Verlustleistung	P_{tot}	-	-	150 mW
$\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$				
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	-25	-	+85 $^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	ϑ_{stg}	-40	-	+85 $^\circ\text{C}$

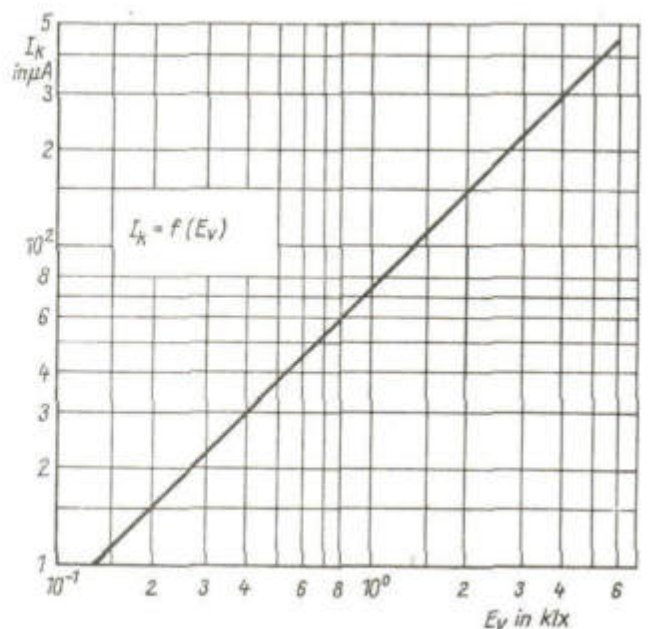
1) gemessen mit Normallicht A nach TGL 37363 in Richtung der geometrischen Achse



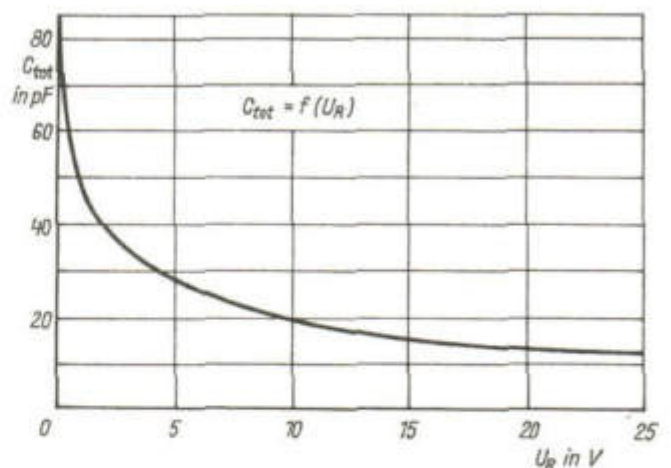
Mittlere spektrale Empfindlichkeit



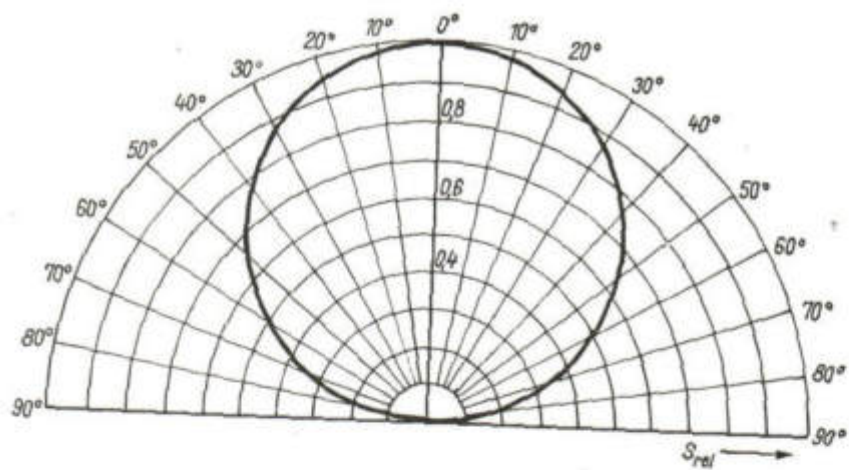
Leerlaufspannung bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke E



Kurzschlußstrom bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke E_v



Sperrschichtkapazität in Abhängigkeit der Spannung



Mittlere Empfangscharakteristik

Änderungen vorbehalten!
Redaktionsschluss Dezember 1986

The logo consists of the letters 'RFT' in a bold, stylized font. The letters are white with black outlines and are set against a background of horizontal black lines.

vew werk für fernsehelektronik berlin
im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1160 Berlin, Ostendstraße
Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007

elektronik
export·import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Telex: BLN 114721 elei